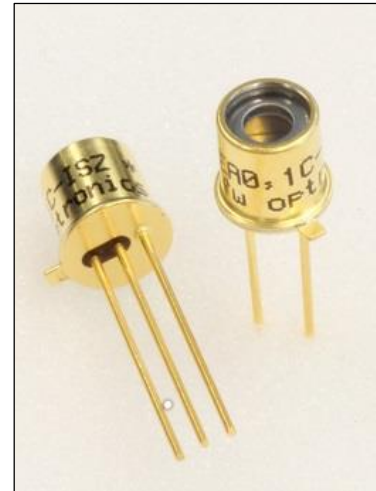


Charakteristik :

- ◆ kleinflächige SiC-Photodiode
- ◆ strahlungsempfindliche Fläche: 0,1 mm²
- ◆ wahlweise Filter für UVC-, UVB- und UVBC-Bereich
- ◆ weitere Filtercharakteristiken auf Anfrage
- ◆ optional in isolierter Ausführung (-ISZ)
- ◆ hermetisches TO18-Gehäuse
- ◆ RoHS, REACH und WEEE konform



Applikationen :

- ◆ universelle Messungen im UV-Bereich mit Einengung des Spektralbereiches
- ◆ Sterilisationslampenüberwachung
- ◆ Flammenüberwachung
- ◆ Sonnenmessung

Grenzwerte :

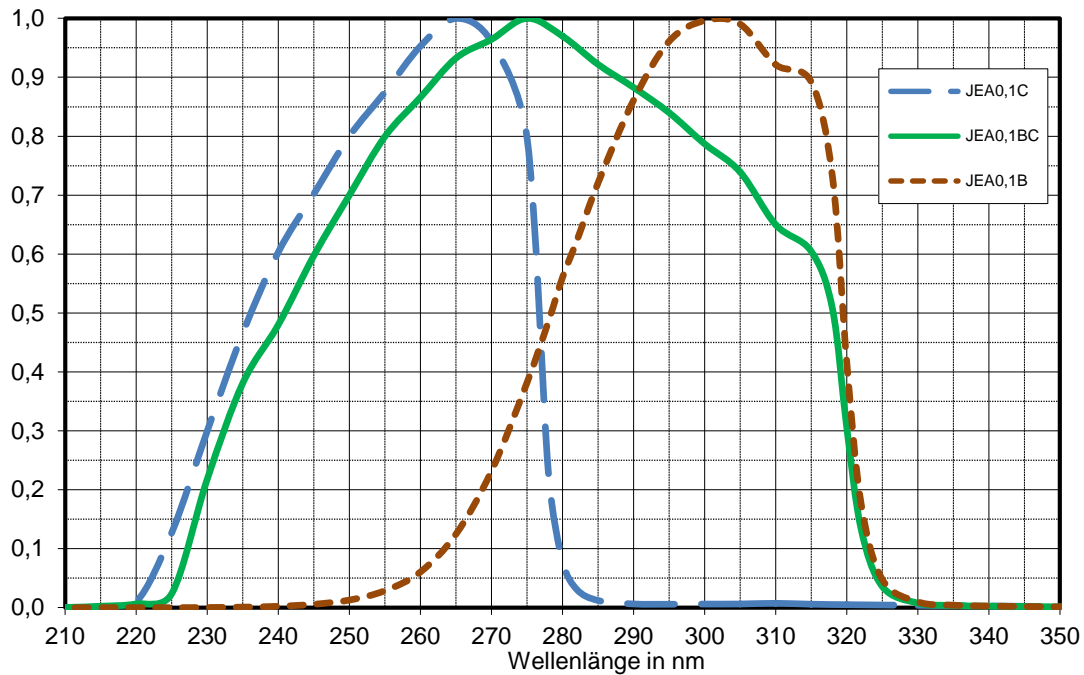
- ◆ Sperrspannung 10 V
- ◆ Betriebstemperaturbereich - 40 °C ... 125 °C
- ◆ Lagertemperaturbereich - 40 °C ... 125 °C
- ◆ Löttemperatur (3s) 260 °C

Technische Daten :

Allgemeine Messbedingungen, sofern nicht anders spezifiziert: T_A = 25 °C , V_R = 0 V

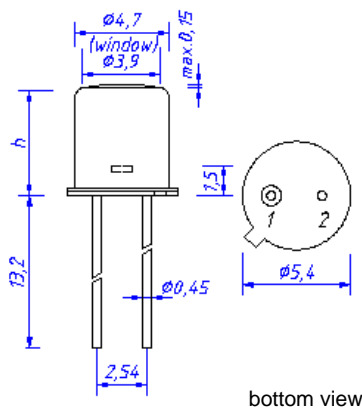
Parameter	Messbedingungen	JEA0,1C-S	JEA0,1BC-S	JEA0,1B-S	Einheit
aktive Fläche		0,365x0,365			mm ²
Spektralbereich					
λ _{min}	S = 0,1 * S _{max}	225	228	265	nm
λ _{max}		280	322	322	nm
Wellenlänge der maximalen spektralen Empfindlichkeit		265	275	300	nm
Spitzenempfindlichkeit S _{max}	S = S _{max}	0,18	0,19	0,12	A/W
Dunkelstrom I _R	V _R = 1 V	10			fA
Sperrschichtkapazität C	f = 10 kHz	30			pF
Öffnungswinkel (FOV)		±25	±25	±25	Grad
Masse		0,4	0,4	0,4	Gramm

relative spektrale Empfindlichkeit



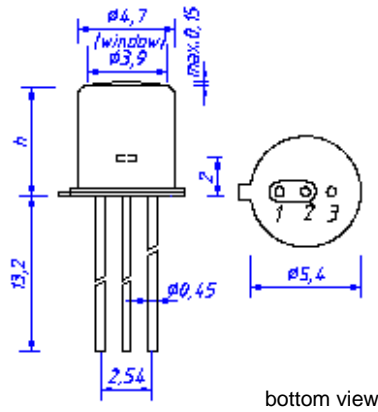
Gehäuseabmessungen (h=5,2 mm)

direkte Montage (Ausführung -S)



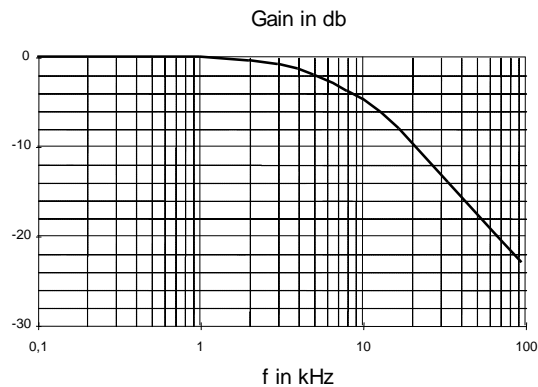
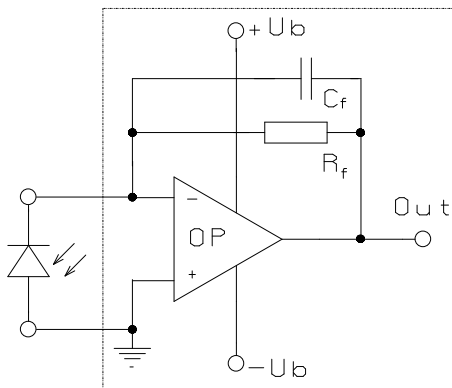
1 Anode
 2 Kathode+Case

isolierte Montage (Ausführung -ISZ)



1 Anode
 2 Kathode
 3 Case

Applikationsbeispiel



Im Applikationsbeispiel ist eine typische Anwenderschaltung dargestellt. R_f bestimmt die Empfindlichkeit der Anordnung. C_f dient zur Kompensation der Sperrschichtkapazität der Photodiode bzw. der Eingangskapazität des OPV. Der genaue Wert von C_f ist abhängig von R_f , vom OPV sowie Streukapazitäten der Schaltung und beträgt typ. 1 pF.

Nebensichendes Diagramm zeigt die Amplitudenabhängigkeit des Applikationsbeispiels mit AD795, $R_f = 10 \text{ M}\Omega$ und $C_f = 1 \text{ pF}$.